

MICROCONTROLADORES

MEMORIA EEPROM

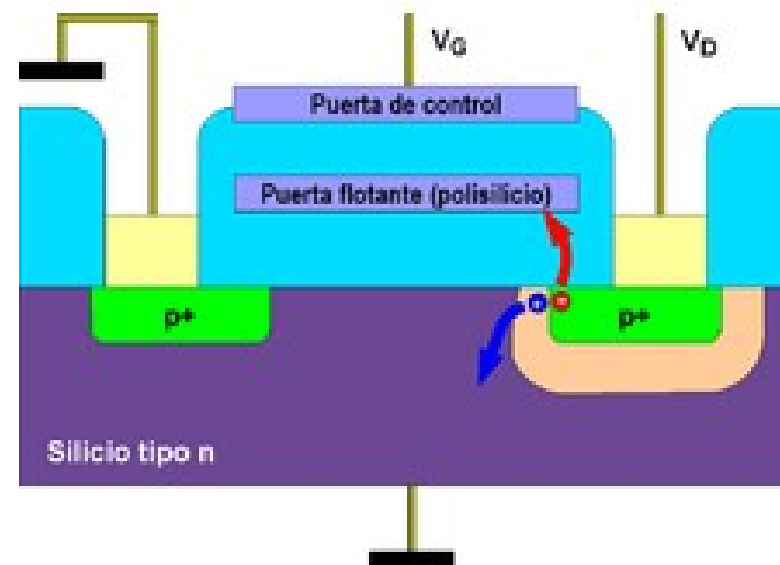
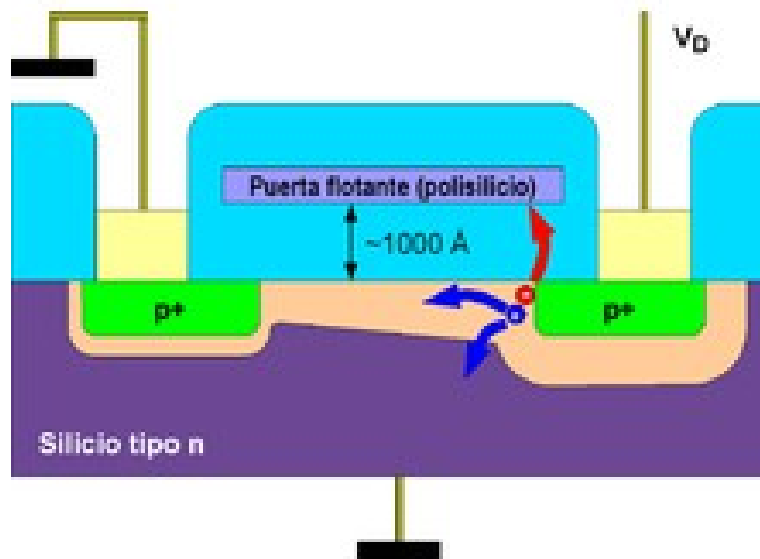
EEPROM: Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, memoria no volátil.

Constituidas por un transistor MOS (Metal-Oxide-Semiconductor) con una compuerta flotante en estado normalmente abierto proporcionando un 1 a la salida. Construidas con una estructura SAMOS.

MEMORIA EEPROM

SAMOS: Stacked-gate Avalanche-injection MOS, es una modificación de una estructura FAMOS, en la que se agrega una segunda compuerta para facilitar la escritura y borrado por medios eléctricos.

FAMOS: Floating-gate Avalanche-injection MOS, transistor MOS con puerta aislada por dióxido de silicio. Se programa polarizando el drenador asta alcanzar la tensión de avalancha.



MEMORIA EEPROM- PIC16F887

1. 256 byte.
2. Un millón de ciclos de escritura, retención de datos por mas de años.
3. Lectura y escritura en tiempo de ejecución.

MEMORIA EEPROM- PIC16F887 SFR

EECON1: Registro de control.

EECON2: Registro de control, No es un registro físico, se usa en la secuencia de escritura de la memoria.

EEDAT: Parte baja de los datos.

EEDATH: Parte alta de los datos.

EEADR: Parte baja de la dirección

EEADRH: Parte alta de la dirección.

Nota: Estos registros se usan también para la escritura y lectura de la memoria Flash.

MEMORIA EEPROM-PIC16F887 EECON1

Controla si el acceso es de escritura o lectura de la memoria y a cual de las memorias se accede (EEPGD).

Los bits RD,WR se clarean por hardware, al completar la operación solicitada.

MEMORIA EEPROM -PIC16F887



MEMORIA EEPROM - PIC16F887

